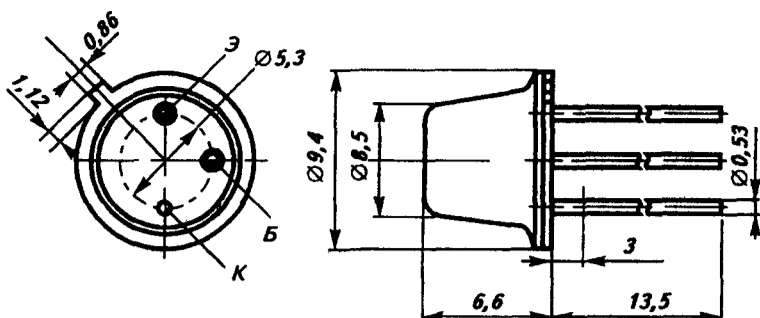


□ 2Т881А, 2Т881Б, 2Т881В, 2Т881Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе с гибкими выводами и стеклянными изоляторами. Масса транзистора не более 2 г.



2Т881А 2Т881Б 2Т881В, 2Т881Г

Электрические параметры

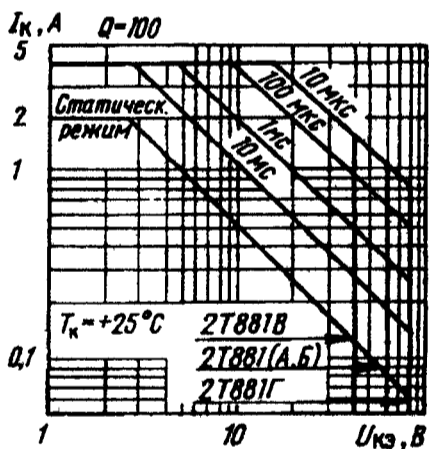
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 1 В, I_э = 1 А$	2Т881А	2Т881Б	2Т881В	2Т881Г	80	250
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В, I_э = 0,05 А$	2Т881А	2Т881Б	2Т881В	2Т881Г	40	160
Граничное напряжение при $I_э = 0,03 А$ не менее	2Т881А	2Т881Б	2Т881В	2Т881Г	60 В	300 МГц
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 1 А, I_б = 0,2 А$ не более	2Т881А	2Т881Б	2Т881В	2Т881Г	40 В	80 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 1 А, I_б = 0,2 А$, не более	2Т881А	2Т881Б	2Т881В	2Т881Г	0,35 В	1,3 В
Время включения при $U_{кэ} = 20 В, I_к = 1 А, I_б = 0,2 А$ типовое значение	2Т881А	2Т881Б	2Т881В	2Т881Г	0,08*	мкс
Время выключения при $U_{кэ} = 20 В, I_к = 1 А, I_б = 0,2 А$ типовое значение	2Т881А	2Т881Б	2Т881В	2Т881Г	0,6*	мкс

Время рассасывания при $U_{кэ} = 20 В, I_к = 1 А, I_б = 0,2 А$, типовое значение	0,5*	мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5 В$, типовое значение	200*	пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 4 В$, типовое значение	900*	пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб, макс}$, макс не более	0,2	мА
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{кэ} = U_{кэ, макс}, R_{бэ} = 1 кОм$, не более	0,5	мА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4,5 В$, не более	1	мА

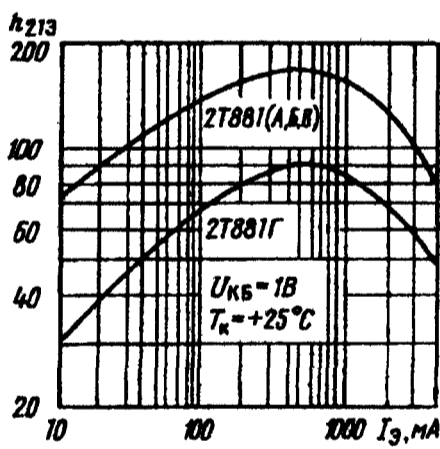
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:	2Т881А, 2Т881Г	100 В
	2Т881Б	80 В
	2Т881В	50 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:		
при $R_{бэ} = 1 кОм$:	2Т881А, 2Т881Г	100 В
	2Т881Б	80 В
	2Т881В	50 В
при $R_{бэ} = ∞$:	2Т881А, 2Т881Б	60 В
	2Т881В	40 В
	2Т881Г	80 В
Постоянное напряжение база-эмиттер		4,5 В
Постоянный ток коллектора		2 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10 мс$		4 А
Постоянный ток базы		1 А
Импульсный ток базы при $t_{и} = 10 мс$		1,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_к = -60...+25^{\circ}C$:		
с теплоотводом		5 Вт
без теплоотвода		0,8 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода		+150 $^{\circ}C$
Температура окружающей среды		-60 $^{\circ}C... T_к = 125^{\circ}C$

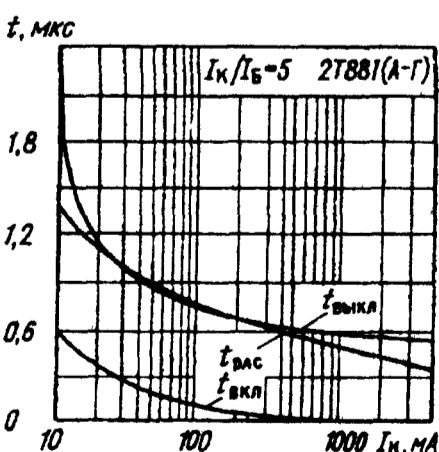
¹ При изменении $T_к$ от +25 до +125 $^{\circ}C$ $P_{к, макс}$ снижается линейно на 0,04 Вт/ $^{\circ}C$ с теплоотводом и на 6,4 мВт/ $^{\circ}C$ без теплоотвода.



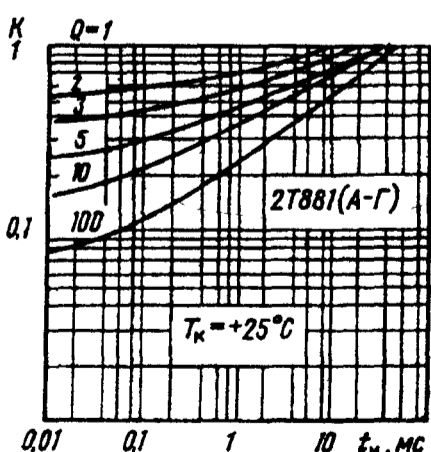
Области безопасной работы транзисторов



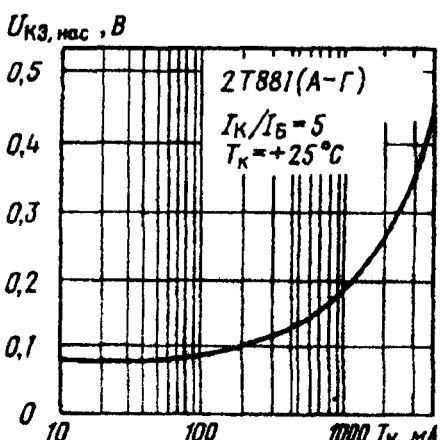
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



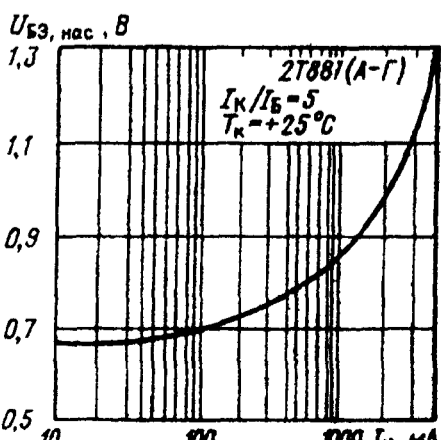
Зависимости времени включения, выключения и рассасывания от тока коллектора



Зависимости коэффициента К от длительности импульса



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора